

半 导 体 学 报

第 8 卷 第 6 期 1987 年 11 月

目 录

- 一维超晶格的子能带和光跃迁.....夏建白 黄 昆 (563)
- 超晶格电子结构的赝势计算.....夏建白 A. Baldereschi (574)
- 适用于 VLSI CAD 的非均匀掺杂小尺寸 MOSFET 阈值电压模型.....
.....王建伟 阮 刚 (585)
- 漏轻掺杂 MOSFET 的特性分析及其解析模型.....
.....谢连生 陈学良 徐元森 (597)
- 用于宏单元阵列的自动布局算法.....于泓涛 洪先龙 (604)
- 双极晶体管表面 $1/f$ 噪声的研究.....庄奕琪 孙 青 (614)
- Al-Mo-Ti-PtSi-Si 金属化系统特性研究
.....陈正明 徐建良 罗晋生 沈文正 (625)
- As⁺ 注入 SOI 的快速热退火研究.....林成鲁 邹世昌 (631)
- 利用有色散双晶衍射测量完整或近完整晶体的单晶反射系数.....
.....陈京一 李润身 许顺生 (637)
- GaAs (100) 表面成分的变化引起费米能级钉扎位置变动的一种新解释.....
.....张翔九 (643)
- 半导体激光器的高频调制光相位不均匀效应.....郭长志 赵一广 (650)

研 究 简 报

- MeV He⁺ 微束用于半导体集成电路的微区分析
.....朱沛然 刘家瑞 张敬平 殷士端 (657)
- n-InP 中深能级的研究.....胡冰华 周炳林 (660)
- 硅中注铅的连续 CO₂ 激光退火行为
.....殷士端 张敬平 顾 诤 陆珉华 (665)
- As-Se 非晶态半导体的结构弛豫对光电导光强关系及瞬态过程的影响.....
.....陈玲荣 闵嗣桂 (670)